

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 品田高宏 副委員長 平野博茂

幹事 池田浩也・諸岡 哲 幹事補佐 森 貴洋・小林伸彰

◎本研究会は参加費が必要になります。

エレソの技報電子化研究会に関する御案内ページ

<https://www.ieice.org/es/jpn/e-gihou-2018es/e-gihou-2018es.htm>

日時 6月25日(月) 11:00~16:55

会場 名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリーベンチャーホール3F(名古屋市千種区不老町B2-4. <http://www.vbl.nagoya-u.ac.jp/access.html>)

議題 MOSデバイス・メモリ高性能化—材料・プロセス技術

1. オフ角を有する m 面 GaN 基板上 GaN-MOS キャパシタの界面準位評価
○出来真斗・安藤悠人・渡邊浩崇・田中敦之・久志本真希・本田善央・天野 浩(名大)
2. Ar または He 希釈リモート酸素プラズマ CVD によって形成した SiO₂/GaN 界面の構造・特性比較
グエン スァン チュン(名大)・○田岡紀之(AIST-NU GaN-OIL)・大田晃生(名大)・山田 永・高橋言緒(AIST-NU GaN-OIL)・池田弥央・牧原克典(名大)・清水三聡(AIST-NU GaN-OIL)・宮崎誠一(名大)
3. 高性能 GaN MOSFET 実現に向けた SiO₂/GaN 界面制御 ○細井卓治・山田高寛・野崎幹人(阪大)・高橋言緒・山田 永・清水三聡(産総研)・吉越章隆(日本原子力機構)・志村考功・渡部平司(阪大)
4. Al₂O₃/n-GaN キャパシタの自然酸化膜層が電気特性へ及ぼす影響 ○弓削雅津也(芝浦工大)・生田目俊秀・色川芳宏・大井暁彦・池田直樹・サン リウエン・小出康夫(物質・研究材料機構)・大石知司(芝浦工大)

午後(13:30~)

5. [依頼講演] 反転層チャネルダイヤモンド MOSFET—ウェットアニール処理による高品質ダイヤモンド MOS 界面の形成— ○松本 翼(金沢大)・加藤宙光・牧野俊晴・小倉政彦・竹内大輔(産総研)・猪熊孝夫(金沢大)・山崎 聡(産総研)・徳田規夫(金沢大)
6. [依頼講演] ダイヤモンドパワー電界トランジスタの進展
○川原田 洋・大井信敬・畢 特・今西祥一郎・岩瀧雅幸・矢部太一・平岩 篤(早大)
7. [依頼講演] ダイヤモンドデバイス応用研究の現状と課題:バルク・表面の結晶品質 ○加藤有香子(産総研)・滝沢耕平(東京都市大)・牧野俊晴・加藤宙光・小倉政彦・竹内大輔・山崎 聡(産総研)・野平博司(東京都市大)
8. リモートプラズマ支援 CVD により形成した SiO₂/GaN 界面の化学結合状態及び熱的安定性評価
○松田亮平・大田晃生・池田弥央・牧原克典・宮崎誠一(名大)
9. 酸素ラジカル照射による Al₂O₃/SiC MOS 界面の改質効果
○土井拓馬(名大)・竹内和歌奈(愛知工大)・坂下満男(名大)・田岡紀之(産総研)・中塚 理・財満鎮明(名大)
10. 第一原理計算による超格子 GeTe/Sb₂Te₃ 相変化メモリの理論的検討
○野原弘晶・白川裕規・洗平昌晃・白石賢二(名大)
11. HfO₂ 系強誘電体薄膜の大きな抗電界がもたらす課題 ○右田真司・太田裕之(産総研)・鳥海 明(東大)
12. X 線光電子分光法に依る Y₂O₃/SiO₂ 界面におけるシリケート化反応及びダイポールの評価
藤村信幸・○大田晃生・池田弥央・牧原克典・宮崎誠一(名大)

◆応用物理学会;シリコンテクノロジー分科会共催

☆SDM 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

8月7日(火)~9日(木) 北大[6月12日(火)] テーマ:アナログ, アナデジ混載, RF 及びセンサインタフェース回路, 低電圧・低消費電力技術, 新デバイス・回路とその応用

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい。

<https://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>

【問合先】

黒田理人(東北大)

TEL [022] 795-4833, FAX [022] 795-4834

E-mail: rihito.kuroda.e3@tohoku.ac.jp